

Содержание

- XXVIII Международный симпозиум „Нанопизика и наноэлектроника“, Нижний Новгород, 11–15 марта 2024 г.

Аксенов В.Ю., Анкудинов А.В., Власов А.С., Дунаевский М.С., Жмерик В.Н., Лебедев Д.В., Лихачев К.В., Перескокова В.А., Минтаилов А.М.

Локальное легирование монослойного WSe₂ на пьезоэлектрических подложках GaInP₂ и GaN 401

Архипова Е.А., Дроздов М.Н., Краев С.А., Хрыкин О.И., Охапкин А.И., Лобаев М.А., Вихарев А.Л., Исаев В.А., Богданов С.А.

Невплавные омические контакты с пониженным сопротивлением к эпитаксиальным слоям алмаза *p*- и *n*-типа и их термическая стабильность 409

- Электронные свойства полупроводников

Вербицкая Е.М., Еремин И.В., Подоскин А.А., Сброжек В.О., Слипченко С.О., Фадеева Н.Н., Яблоков А.А., Еремин В.К.

Дрейфовый перенос носителей заряда в кремниевых *p*⁺-*n*-*p*⁺-структурах при температурах ≤ 100 мК 415

Буга С.Г., Куприянов И.Н., Борздов Ю.М., Кузнецов М.С., Лупарев Н.В., Носухин С.А., Кульницкий Б.А., Приходько Д.Д., Пальянов Ю.Н.

Электрические свойства сильно легированных азотом синтетических монокристаллов алмаза, выращенных при высоком давлении и температуре 424

- Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления

Миньков Г.М., Рут О.Э., Шерстобитов А.А., Германенко А.В., Дворецкий С.А., Михайлов Н.Н.

Магнитотранспорт в квантовых ямах HgTe с двумя полевыми электродами 434

- Аморфные, стеклообразные, органические полупроводники

Фефелов С.А., Казакова Л.П., Богословский Н.А., Былев А.Б., Гущина Е.В., Толепов Ж.К., Жакпоров А.С., Приходько О.Ю.

Влияние примеси Bi на основные параметры вольт-амперных характеристик полупроводника с фазовой памятью Ge₂Sb₂Te₅ 443

- Микро- и нанокристаллические, пористые, композитные полупроводники

Николаенко Ю.М., Эфрос Н.Б., Мезин Н.И., Решидова И.Ю.

Фундаментальный и прикладной аспекты физических характеристик поликристаллических образцов оксидного полупроводника (In₂O₃)_{1-x}:(SrO)_x 448

- Физика полупроводниковых приборов

Соболев М.М., Солдатенков Ф.Ю., Козлов В.А.

Выявление основных каналов рекомбинации в слабо легированных слоях GaAs *p-i-n*-диодов до и после облучения 1 МэВ нейтронами 453